Non-stoechiométrie par "Intercroissance" dans les Siliconiobates de Baryum. Les Composés (Ba₃Nb₆Si₄O₂₆) " . Ba₃Nb₄Ti₄O₂₁

NINH NGUYEN, FRANCIS STUDER, DANIEL GROULT, JACQUES CHOISNET, ET BERNARD RAVEAU

Groupe de Cristallographie et Chimie du Solide de l'Université de Caen, Laboratoire associé au C.N.R.S. No. 251, Esplanade de la Paix 14032 Caen Cedex, France

Received July 6, 1976

Une nouvelle famille structurale de formule générale (Ba₃Nb₆Si₄O₂₆)_n. Ba₃Nb₄Ti₄O₂₁ où 2n prend une valeur entière a été mise en évidence dans le système Ba₃Nb₆Si₄O₂₆-Ba₃Nb₄Ti₄O₂₁. La structure de ces phases est caractérisée par l'intercroissance des deux types structuraux Ba₃Nb₆Si₄O₂₆ et Ba₃Nb₄Ti₄O₂₁. Les membres de cette famille correspondant aux valeurs de n = 1, 2, et 3 ont été isolés et étudiés par diffraction X et microscopie électronique. L'étude de microcristaux correspondant à la composition Ba₁₅Nb₂₈Ti₄Si₁₆O₁₂₅ (n = 4) a permis de mettre en évidence trois types de compositions différentes, à savoir les termes n = 3, n = 5, et n = 4.5. Le terme n = 4 a également été observé, à l'issue de recuits prolongés à 1300°C.

A new family with general formula $(Ba_3Nb_6Si_4O_{26})_nBa_3Nb_4Ti_4O_{21}$ (2*n* takes an integral value) was synthesized in $Ba_3Nb_6Si_4O_{26}-Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$ system. The structure of these compounds shows the intergrowth of two structural types: $Ba_3Nb_6Si_4O_{26}$ and $Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$. Members of this family with *n* values = 1, 2, and 3 have been studied by X-ray diffraction and electron microscopy. For $Ba_{15}Nb_2 Ti_4Si_{16}O_{125}$ (n = 4) composition, electron diffraction results are consistent with the existence of different compositions: n = 3, n = 5, and n = 4.5. n = 4 member was obtained by heating at 1300°C for long periods.

Les précédentes études des niobates et tantalates substitués d'ions monovalents et bivalents de grande taille, mettent en évidence deux nouvelles familles de composés dont les structures présentent de grandes analogies: les siliconiobates et silicotantalates A_3M_6 - Si_4O_{26} ou $A_6M_6Si_4O_{26}$ (A = Ba, Sr ou K; M = Ta, Nb) synthétisés et étudiés par Shannon et Katz (1) (2) et au laboratoire (3)et les niobates A_3 Nb_{8-x} M_xO_{21} (A = Ba, K; M = Nb, Ti, Cr, Fe, Ni, Mg, Zn) que nous avons décrits dans une récente publication (4). Ces résultats laissent penser que le composé Ba_{6+x}Nb₁₄Si₄O₄₇ (5) représente un terme particulier d'une intercroissance entre les deux structures limites $A_3M_6Si_4O_{26}$ et $A_3M_8O_{21}$. Le présent travail est donc relatif à une série inédite de composés de formulation $(Ba_3Nb_6Si_4O_{26})_n$. $Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$.

Rappel de la Structure de $Ba_3Nb_6Si_4O_{26}$

La structure de Ba₃Nb₆Si₄O₂₆ a été établie à partir d'un monocristal par Shannon et Katz (1). La maille hexagonale a pour paramètres a = 9.00 Å c = 7.89 Å. Le groupe spatial est $P\overline{6}2m$ avec Z = 1. Le "réseau hôte" de ce composé est constitué de triples files d'octaèdres NbO₆ parallèles à l'axe c de la maille hexagonale, jointes entre elles par des groupements Si₂O₇ et formant des tunnels de section pentagonale à demi-occupés par les ions baryum. (Fig. 1). Plusieurs composés de même type structural ont été isolés récemment $(2, 3): A_3Ta_6Si_4O_{26}$ (A = Ba, Sr) et K₆M₆-Si₄O₂₆ (M = Ta, Nb); les composés du potassium se distinguent toutefois de Ba₃Nb₆Si₄O₂₆

Filiation Structurale

Copyright () 1976 by Academic Press, Inc. All rights of reproduction in any form reserved, Printed in Great Britain



FIG. 1. Projection suivant l'axe c de la structure $A_3M_6Si_4O_{26}$ et $K_6M_6Si_4O_{26}$ (A = Ba, Sr; M = Ta, Nb).



FIG. 2. Projection suivant l'axe c d'une couche MgO₂₁: cas du composé Ba₃Nb₄Ti₄O₂₁.

par une occupation totale des tunnels de section pentagonale par les ions potassium.

Rappel de la Structure des phases $A_3M_8O_{21}$

Une série d'oxydes ternaires de niobium de formule générale $A_3M_8O_{21}$ a été récemment synthétisée et caractérisée au laboratoire (4). Ces composés cristallisent dans une maille hexagonale de paramètres a voisin de 9 Å et *c* voisin de 12 Å avec Z = 2 (a = 9.04 Å, c = 11.76_7 Å pour Ba₃Nb₄Ti₄O₂₁). L'exploitation des clichés de diffraction électronique et des diffractogrammes X de poudre de ces phases a permis de décrire la structure dans le groupe spatial $P6_3/mcm$. L'unité structurale de base de ces composés est constituée par un bloc élémentaire de composition M_6O_{24} , formé de (3×2) octaèdres joints entre eux par les arêtes et les sommets. Chacun de ces blocs se développe suivant c, en formant des chaînes infinies M_6O_{21} associées entre elles par l'intermédiaire d'octaèdre MO_6 , dont l'axe ternaire est parallèle à c. Ce réseau d'octaèdres constitue parallèlement au plan (00.1) des couches de composition $(M_8O_{21})_n$ (Fig. 2) dont l'empilement suivant c détermine des cages prismatiques dans lesquelles sont insérés les ions A (potassium ou baryum).



FIG. 3. Représentation schématique de la structure des trois premiers membres de la famille $(Ba_3Nb_6Si_4O_{26})_n$. Ba₃Nb₄Ti₄O₂₁. Les triples files d'octaèdres sont jointes entre elles par des groupes Si₂O₇ (couche Ba₃Nb₆Si₄O₂₆) ou des octaèdres NbO₆ d'axe ternaire parallèle à c. (a) n = 1; (b) n = 2; (c) n = 3.



FIG. 4. Diffraction électronique dans le plan 00.1 pour le composé $Ba_6Nb_{10}Ti_4Si_4O_{47}$.



FIG. 5(a et b). Diffraction électronique dans le plan (I1.0) et résolution des plans (00.1) pour le composé $Ba_6Nb_{10}Ti_4Si_4O_{47}$ (n = 1).



Fig. 6b. Résolution des plans (00.1) équidistants de 43.16 Å pour le terme n = 2 de l'intercroissance.



FIG. 7a. Plan (01.0) de diffraction électronique pour le terme n = 3 de la série (Ba₃Nb₆Si₄O₂₆)_n. Ba₃Nb₄Ti₄-O₂₁. Les conditions de réflexions ho.1: l = 2n sont conservées pour tous les termes où *n* est entier.



FIG. 7b Résolution des plans (00.1) équidistants de 59 Å et des plans (00.2) equidistants de 29.51 Å pour le terme n = 3.

Hypothèse Structurale d'une nouvelle Famille $(A_3M_6Si_4O_{26})_n$. $A_3M_8O_{21}$ Le composé $Ba_{6+x}Nb_{14}Si_4O_{47}$

La quasi-identité des paramètres "*a*" observés pour les mailles hexagonales des structures $A_3M_6Si_4O_{26}$ et $A_3M_8O_{21}$, nous amène à comparer les deux réseaux. Dans les deux cas, les octaèdres MO₆ dont les "axes" des liaisons O-M-O sont sensiblement parallèles à c, sont enchaînés dans le plan (00.1) de façon analogue, par l'intermédiaire de triangles O₁ et de pentagones O₅. De cette remarque, il découle qu'un feuillet de composition $A_3M_6Si_4O_{26}$ peut être juxtaposé à un feuillet de composition $A_3M_8O_{21}$, par simple mise en commun des sommets des octaèdres MO_6 . On peut alors envisager l'existence d'une famille de composés $(A_3M_6Si_4O_{26})_n \cdot A_3M_8O_{21}$ caractérisés par l'intercroissance de feuillets $A_3M_8O_{21}$, d'épaisseur $c_{A_3M_8O_{21}}/2$ et de feuillets siliconiobates ou silicotantalates d'épaisseur $n.c_{A_3M_6Si_4O_{26}}$, s'étendant parallèlement au plan (00.1).

Les structures de ces phases sont représentées de façon schématique sur les Figs. 3a, 3b, et 3c pour les trois premiers membres de cette famille. Lorsque *n* augmente, chaque terme de cette famille se déduit du précédent par addition de deux motifs $A_3M_6Si_4O_{26}$ par maille. Les paramètres de la maille cristalline peuvent alors être reliés à ceux des composés $A_3M_6Si_4O_{26}$ et $A_3M_8O_{21}$ de la façon suivante:

$$a_n = a_{A_3 M_6 Si_4 O_{26}} \sim a_{A_3 M_8 O_{21}} \sim 9 \text{ Å}$$
(1)

$$c_n = c_{A_3M_8O_{21}} + 2n.c_{A_3M_6Si_4O_{26}}$$

~ 12 + 2n × 7.9 Å (2)

Les résultats obtenus par Evans et Katz (5) pour le composé $Ba_{6+x}Nb_{14}Si_4O_{47}$ sont en accord avec notre modèle. La structure de cette phase qui correspond à n = 1, peut, en effet, être décrite par intercroissance de feuillets "Ba₃Nb₈O₂₁" et de feuillets Ba_{3+x}Nb₆Si₄-O₂₆, conduisant à une maille hexagonale de paramètres a = 9.034 Å, c = 27.81 Å, avec pour groupe spatial P6₃/mcm et Z = 2. Sa représentation schématique est celle du terme n = 1, telle qu'elle apparaît sur la Fig. 3a.

Les Trois Premiers Membres de la Serie (Ba₃Nb₆Si₄O₂₆)_n. Ba₃Nb₄Ti₄O₂₁

Dans les systèmes $A_3M_6Si_4O_{26}-A_3M_8O_{21}$, nous avons choisi les composés du niobium qui donnent généralement des microcristaux de meilleure qualité que ceux du tantale et permettent une étude systématique par diffraction et microscopie électronique (6, 7). Le titanoniobate Ba₃Nb₄Ti₄O₂₁ et le siliconiobate Ba₃Nb₆Si₄O₂₆ étaient susceptibles de conduire aux meilleurs résultats en raison des

TABLEAU I

 $Ba_6Nb_{10}Ti_4Si_4O_{47}$: a = 8.993 Å et c = 27.43 Å

hk.l	d _{obs}	d _{calc}
00.2	13.71	13.715
00.4	6.85 ₆	6.857
10.4	5.143	5.146
00.6	4.57 ₃	4.571
11.0	4.49₄	4.496
11.1	4.43 ₆	4.437
11.3	4.03 ₃	4.034
10.6	3.942	3.942 ₆
20.0	3.89 ₃	3.894 _o
11.4	3.7594	3.760 ₂
11.5	3.4771	3.477 ₆
00.8	3.4285	3.4287
20.4	3.3853	3.3862
11.6	3.2052	3.2057
10.8	3.138 ₀	3.1381
11,7	2.954 ₈	2.9542
21.0	2.9444	2.943 ₆
21.1	2.926 ₅	2.926 ₈
21.3	2.8014	2.802 _o
00.10	2.743 ₅	2.743 ₀
30.0	2.5961	2.596 ₀
20.8	2.573 ₇	2.5734
21.6	2.475 ₇	2.4749
20.10	2 241	2.242s
22.1	2.2419	2.2407
22.3	2.182 ₈	2.183 ₂
31.1	2.1534	2.1534
31.3	2.1025	2.1022
30.8	2.0689	2.0697
31.4	2.060 ₆	2.060 ₂
11.12	2.0385	2.037 ₆
21.10	2.0072	2.0067
00.14	1.960 ₂	1.959 ₃
40.0	1.947,	1.947 ₀

$Ba_9Nb_{16}Ti_4Si_8O_{73}$: $a = 8.994$ Å et $c = 43.16$ Å					
hk.l	dobs	d _{calc}	hk.l	, d _{obs}	d _{calc}
00.2	21.54	21.58	11.10	3.1151	3.113,
00.4	10.79	10.79	11.11	2.9572	2.956₅
10.0	7.78 ₃	7.789	21.0	2.944 ₈	2.943,
10.2	7.31	7.326	21.1	2.9384	2.937 ₂
00.6	7.20 ₀	7.193	20.10	2.890 ₉	2.8914
10.4	6.321	6.315	21.3	2.8845	2.8842
10.6	5.28 ₃	5.285	21.5	2.7866	2.7864
11.0	4.492	4.497	00.16	2.696	2.6975
11.1	4.47 ₀	4.473	20.12	2.641 ₈	2.6423
00.10	4.316	4.316	30.0	2.5960	2.596 ₃
11.5	3.99 ₀	3.988	21.8	2.585	2.584 ₃
20.0	3.893	3.894₅	21.10	2.4325	2.4321
11.6	3.810	3.813 ₂	22.2	2.236	2.2364
10.10	3.774 ₈	3.7752	11.17	2.2112	2.210 ₈
11.7	3.6331	3.6333	22.5	2.1757	2.175,
00.12	3,599 ₈	3.5967	31.0	2.1606	2.160 ₃
11.8	3.4501	3.454 ₃	00.20	2.1577	2.158 ₀
20.6	3.424	3.424 ₈	31.5	2.0953	2.0957
10.12	3.263	3.2653	00.22	1.962 ₀	1.961
20.8	3.1582	3.1577	40.0	1.947 ₃	1.9473

TABLEAU II

TABLEAU III Ba₁₂Nb₂₂Ti₄Si₁₂O₉₉: a = 8.990 Å et c = 58.87 Å

hk.l	dobs	d _{cate}	kh.l	dobs	dcate
00.2	29.39	29.435	20.12	3.049 ₈	3.0493
00.4	14.76	14.717	11.1		2.956 ₃
00.6	9.79	9.811	00.20 }	2.946	2.943 ₅
10.0	7.777	7.785	21.0		2.9426
10.2	7.514	7.526	21.3	2.911 ₆	2.910 ₁
00.8	7.367	7.358	20.14	2.954	2.856
10.8	5.345	5.347	21.5	2.854	2.854 ₈
11.0	4.491	4.495	21.7	2.777 ₀	2.7775
00.14	4.202	4.205	21.9	2.6841	2.6836
11.7	3.963	3,964	20.16	2.672 ₈	2.673,
20.0	3.891 ₅	3.8927	11.18	2.6437	2.644 ₆
11.8	3.8361	3.835,	30.0	2.595 ₃	2.595 ₁
20.4	3.7672	3.763 ₃	20.18	2.5033	2.504 _o
11.9	2 70	3.7046	21.14	2.4112	2.410,
10.14	3.70 ₃	3.699 ₈	21.16	2.297,	2,298 ₀
00.16	3.679 ₀	3.679 ₃	30.12	2.293 ₂	2.293,
20.6	3.616 ₀	3.6184	22.1	2.245,	2.245 ₈
11.10	3.5734	3.572 ₆	11.23	2.2241	2.2242
11.11)	2 441	3.442 ₀	20.22	2.205 ₈	2.2051
20.8	5,441	3.440,	22.7	2.1704	2.171 ₃
10.16	3.326	3.3266	31.0	2.1584	2.159 ₃
20.10	3.2462	3.247 ₀	31.7	2.091 ₀	2.0914
11.13	3.1884	3.190 ₂	31.8	2.071 ₀	2.071,
11.14	3.069 ₈	3.070 ₇	00.30	1.9617	1.962 ₃



FIG. 8(a et b). Ces deux photos de diffraction électronique ont été obtenues à partir de deux microcristaux différents pour la composition globale Ba₁₅Nb₂₈Ti₄Si₁₆O₁₂₅ correspondant au terme n = 4. Elles montrent dans les deux cas le plan ($\overline{11.0}$) de la structure et correspondent respectivement au terme n = 3 ($d_{00.1} = 59$ Å) et n = 5 ($d_{00.1} = 91$ Å).

valeurs très voisines du paramètre a de leurs mailles cristallines. C'est pourquoi, l'étude du système $Ba_3Nb_6Si_4O_{26}$ - $Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$ a été envisagée.

Synthèse Chimique des Phases $(Ba_3Nb_6Si_4O_{26})_n$. $Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$

Les différents composés $(Ba_3Nb_6Si_4O_{26})_n$. $Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$ ont été préparés à partir des oxydes $Ba_3Nb_6Si_4O_{26}$ et $Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$ pris dans les proportions stoechiométriques. Ces produits de départ ont été synthétisés selon des modes opératoires décrits par ailleurs (1-4). Les mélanges ainsi constitués subissent une série de recuits de 12 heures, à l'air, aux températures suivantes: 900°C, 1100°C, 1250°C. Un recuit final est effectué à 1300°C, dont la durée est d'autant plus longue que la

TABLEAU IV

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES DES COMPOSÉS $(Ba_3Nb_6Si_4O_{26})_n Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$ n = 1, 2,et 3.

n	Composés	a (Å)	c (Å)	d_{exp}	d_{theor}
1	Ba ₆ Nb ₁₀ Ti₄Si₄O₄7	8.993	27.43	4.84	4.85
2	Ba9Nb16Ti4Si8O73	8.994	43.16	4.75	4.73
3	$Ba_{12}Nb_{22}Ti_{4}Si_{12}O_{99}$	8.99	58.87	4.70	4.68



FIG. 9. Pour les termes non entiers de la série (n = 1.5-2.5-3.5-4.5...) la condition de réflexion ho.l: l = 2ndans le plan (01.0) disparaît, ainsi que le montre la diffraction électronique obtenue pour n = 4.5 ($d_{00.1} = 83$ Å). La microscopie électronique montre les plans (00.1) ainsi que les plans (00.2) intermédiaires, correspondant à une distance de 41.5 Å.

valeur de *n* est plus élevée. Dans ces conditions trois nouvelles phases ont été isolées; Ba_6Nb_{10} - $Ti_4Si_4O_{47}$, $Ba_9Nb_{16}Ti_4Si_8O_{73}$, et $Ba_{12}Nb_{22}Ti_4$ - $Si_{12}O_{99}$. Elles correspondent respectivement aux termes n = 1, 2, ct 3 de la série ($Ba_3Nb_6Si_4$ - $O_{26})_n$ · $Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$.

Etude par Diffraction X et Microscopie Electronique

Les études par diffraction X sur poudre au moyen d'un goniomètre Philips pour la raie

K α du cuivre, et par microscopie électronique au moyen d'un microscope Philips EM 200 ont été menées simultanément pour ces trois composés. Dans les trois cas, nous observons une maille hexagonale de paramètre a voisin de 9 Å. L'examen des diffractogrammes X ne révèle aucune condition d'extinction sur les réflexions (hk.0) cette observation est confirmée par les clichés de diffraction électronique du plan (hk.0) (Fig. 4). Les clichés de diffraction électronique des plans (ho.l) (Figs. 5a,



FIG. 10. Représentation schématique du terme n = 4.5.

6a, 7a) mettent en valeur un système de taches bien résolues et révèlent pour ces trois phases la règle d'extinction (*ho.l*) l = 2n + 1, en accord avec l'indexation des diffractogrammes de poudre (Tableaux I, II, III).

La résolution directe des plans du réseau par microscopie électronique, effectuée sur des microcristaux orientés de telle sorte que les plans (*hk.o*) soient parallèles au faisceau électronique, a permis d'établir sans ambiguité les valeurs du paramètre c. Les micrographies obtenues font, en effet, apparaître un système régulier de franges qui peuvent être aisément corrélées avec les valeurs théoriques du paramètre c proposées plus haut. La Fig. 5b relative au composé Ba₆Nb₁₀-Ti₄Si₄O₄₇ est caractérisée par un interfrange de 28 Å qui correspond bien à la valeur prévue pour le terme n = 1 (~27.8 Å). Dans le cas du composé Ba₉Nb₁₆Ti₄Si₈O₇₃, nous observons un interfrange voisin de 43 Å (Fig. 6b), en accord avec la valeur théorique correspondant au terme n = 2 (~43.6 Å). Il en est de même pour le terme n = 3, soit Ba₁₂Nb₂₂-Ti₄Si₁₂O₉₉, pour lequel un interfrange de 59 Å a été observé (Fig. 7b).

Les paramètres cristallins de ces composés, affinés à partir des valeurs des distances réticulaires observées sur les diffractogrammes X (Tableaux I, II, III) sont donnés au Tableau IV. Les densités observées impliquent dans ces trois cas deux motifs $(Ba_3Nb_6Si_4O_{26})_n$. $Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$ par maille.

La Composition $Ba_{15}Nb_{28}Ti_4Si_{16}O_{125}$. Le Terme n = 4.5

Des recuits à 1300°C, de $(3 \times 12 \text{ h})$, pour la composition Ba₁₅Nb₂₈Ti₄Si₁₆O₁₂₅ n'ont pas permis d'isoler le terme n = 4. Dans ce cas, les diffractogrammes X correspondant à cette composition sont naturellement très voisins de celui de Ba₃Nb₆Si₄O₂₆. Par ailleurs, la valeur théorique très élevée du paramètre c ($c \sim 75$ Å), ne permet pas de mettre en évidence de raies de surstructure. L'étude par diffraction et microscopie électroniques met en évidence pour cette composition un mélange de phases. Trois types de cristaux ont été principalement obtenus. Les deux premiers types sont caractérisés par des mailles hexagonales de paramètres a voisin de 9 Å et de paramètres c respectivement égaux à 59 Å et 91 Å (Figs. 8a, 8b); ils peuvent être identifiés sans ambiguité aux termes n = 3 et n = 5de la série $(Ba_3Nb_6Si_4O_{26})_n$. $Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$. La troisième catégorie de cristaux correspond à un paramètre c voisin de 83 Å comme le montre la Fig. 9 qui représente les réflexions (ho.1) et la résolution directe des plans (oo.1). Ce composé se distingue des autres termes de la série par l'absence de condition d'extinction pour les réflexions (ho.l). Ces résultats sont compatibles avec le terme n = 4.5 pour lequel la valeur théorique du paramètre déduite de la relation (2) est voisine de 83.1 Å. Dans ces conditions, la structure du terme n = 4.5, $Ba_{33}Nb_{62}Ti_8Si_{36}$ - O_{276} , résulte de l'intercroissance de feuillets $(Ba_3Nb_6Si_4O_{26})_5$, $Ba_3Nb_4Ti_4O_{21}$, et $(Ba_3Nb_6-$ Si₄O₂₆)₄ ordonnés suivant le schéma de la



FIG. 11(a–c). Représentation schématique des termes n = 1.5, 2.5, et 3.5.

Fig. 10. L'existence des termes n = 1.5; 2.5; 3.5 dont la structure peut être prévue (Figs. 11a, 11b, 11c), est alors vraisemblable.

Des recuits prolongés de cette même composition Ba₁₅Nb₂₈Ti₄Si₂₆O₁₂₅ à 1300°C pendant 3 jours, ont fait apparaître le terme n = 4. Le paramètre $c \simeq 75$ Å a été déterminé par microscopie et diffraction électronique.

Par ailleurs, certains cristaux présentent des interfranges d'épaisseur différente, dues probablement à des variations locales de stoechiométrie. Une étude systématique des termes correspondant à des valeurs de n non entières est actuellement en cours.

Conclusion

Les résultats obtenus au cours de cette étude mettent en évidence une nouvelle famille structurale $(A_3M_6\text{Si}_4\text{O}_{26})_n$. $A_3M_8\text{O}_{21}$ résultant de l'intercroissance de deux types structuraux $A_3M_6\text{Si}_4\text{O}_{26}$ et $A_3M_8\text{O}_{21}$. Un mécanisme du même type pour les compositions riches en niobate $A_3M_8O_{21}$, conduisant aux composés $(A_3M_8O_{21})_n$. $A_3M_6Si_4O_{26}$ est également envisagé. Les phénomènes de nonstoechiométrie sur les ions A dans ce type de composés feront l'objet d'une étude ultérieure.

Bibliographie

- 1. J. R. SHANNON ET L. KATZ, Acta Cryst. **B26**, 105 (1970).
- 2. J. R. SHANNON ET L. KATZ, J. Solid State Chem. 1, 399 (1970).
- 3. J. CHOISNET, N. NGUYEN, D. GROULT, ET B. RAVEAU Mat. Res. Bull., 11, 887 (1976).
- D. GROULT, J. M. CHAILLEUX, J. CHOISNET, ET B. RAVEAU, J. Solid State Chem. 19, (1976) sous presse.
- 5. D. M. EVANS ET L. KATZ, J. Solid State Chem. 8, 150 (1973).
- 6. J. G. ALLPRESS ET R. S. ROTH, J. Solid State Chem. 3, 209 (1971).
- 7. F. STUDER ET B. RAVEAU, Acta Cryst. B31, 2774 (1975).